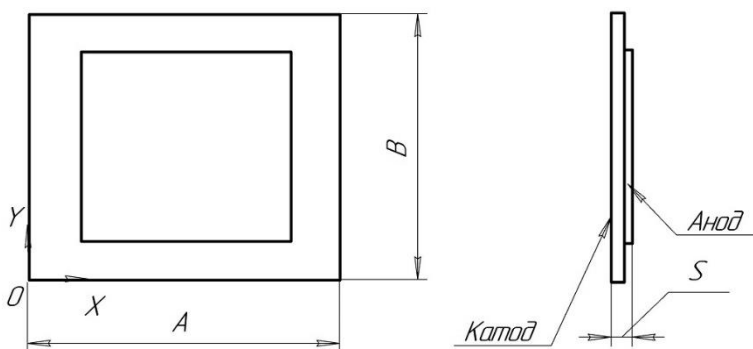



**Кристалл ультрабыстрого высоковольтного диода с мягкой характеристикой обратного восстановления  $U_{обр.} = 600В$** 

Отличительные особенности:

- Эпитаксиально-планарная технология
- Низкое прямое падение напряжение
- Высокое быстродействие
- Малые значения обратных токов

**Габаритные размеры**


<b>A</b>	Размер кристалла, мм	3,3
<b>B</b>	Размер кристалла, мм	3,31
<b>S</b>	Толщина кристалла, мм	0,35
Металлизация анода		Al-Ti
Металлизация катода		Ti-Ni-Ag
Пассивация		SiO <sub>2</sub>
Ширина линии скрайбирования, мм		0,06

**Общее описание**

Разрабатываемые кристаллы ультрабыстрых диодов предназначены для использования в выпрямителях высокой частоты, модуляторах, преобразователях, формирователях импульсов, ограничителях и других импульсных устройствах. Электрические характеристики подтверждаются тестированием 100 % кристаллов в нормальных условия ( $T_A=25\text{ }^\circ\text{C}$ ) по основным параметрам :  $U_{обр.}$ ,  $I_{обр.}$ , а также выборочным тестированием кристаллов на каждой пластине по параметру  $U_{пр.}$  при номинальном значении прямого тока  $I_{пр.ср.}$

**Основные параметры и характеристики**

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение параметра	Предельно-допустимый режим	
		не менее	не более
Постоянное обратное напряжение, В	$U_{обр.}$	650	-
Постоянный прямой ток, А	$I_{пр.}$	-	10
Время обратного восстановления, нс ( $I_{пр.}=1А, U_{обр.}=30В, dI_{пр.}/dt=100А/мкс$ )	$T_{вос.обр}$	-	120

**2Д2145А-5****Электрические параметры**

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Обозначение параметра	Норма параметра			Температура среды, °С
		не менее	типовое	не более	
Средний прямой ток (в составе корпуса у потребителя), А	$I_{\text{пр.ср.}}$	-	-	10	25±10
Постоянное прямое напряжение, В $I_{\text{пр.ср.}}=10$ А	$U_{\text{пр.}}$	-	-	1,2	
Постоянный обратный ток, мА ( $U_{\text{обр.}} = 600\text{В}$ )	$I_{\text{обр.}}$	-	-	0,01	
Постоянный обратный ток, мА ( $U_{\text{обр.}} = 600\text{В}$ )	$I_{\text{обр.}}$	-	-	1,5	125±5